mikroe ektror

Information



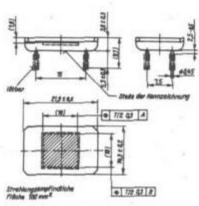
SP 119, SP 121

2/88 (13)

Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin

Optische Positionssensoren

Die nichtunterteilten optischen Positionssensoren sind in Si-Planartechnologie gefertigt. Das Gehäuse ist aus Metall-Glas.

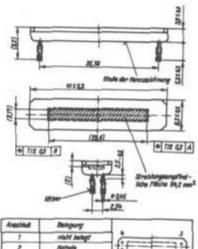


Anschlut	Salegorg	4
1	Auto04	- (FFT)
1	Andr] ++++-
3	Astroit.	
	Anada	

Anschluß 1 ist durch andersfarbige Ein-schmelsung oder Farbpunkt gekenntelshnet

Masse: 4,2 g

Bild 1: Maßbild SP 119



Ansolvet	Belegung	100
7	minist beings	7
2	Alleforde	t:===:
3	Aneale 1	1 1
	Anode Z	

Masse: 5 o

Bild 2: MaGbild SP 121

SP 119 sind zweidimensionale, positionsempfindliche, SP 121 1-dimensionale positionsempfindliche Fotodioden. Diese Fotodioden zeichnen sich durch eine hohe Empfindlichkeit, geringes Dunkelstromniveau und gute Homogenität der spektralen Empfindlichkeit aus.

Grenzwerte

SP 121

45	Kurzzeichen	min.	ma	х.	Einheit
Sperrgleichspannung					
A = -25 °C70 °C	II.	12.0	25		V
a27 070 0	UR				*
Verlustleistung					
A ≈ -25 °C70 °C	Ptrn	-	30	0	mW
Sperrschichttempe-					******
ratur	2,	-	12	5	OC
Betriebstemperatur-	A				0
bereich	a	-15	70	0	°C
Lagerungstemperatur-	D				
bereich	stg	-25	85		OC
Kenngräßen ($\partial_{\mathbf{B}}^{\mathbf{h}} = 25$ °C)					
			2.75		
	Kurzzeichen	min.	typ.	max.	Einheit
Dunkelsperrstrom	IRO				
E _e = 0 1x	KU				
U _R = 20 V					
100			0,2	4	
SP 119		-			μА .
SP 121		*	0,2	2	μА
Spektrale	1)				
Empfindlichkeit	5a 1)				
λ = 633 nm					
u _R = 20 V					
λ ₀ s = 10 nm					
R_ < 100 Ohm		101124			
SP 119		0,25	0,3	•	A/W
SP 121		0,25	0,3		A/W
Spektraler	2 -				
Empfindlichkeits-					
bereich = 10 nm					
$S(\lambda) = 10 \% S(\lambda_{max})$					
UR = 20 V,					
$R_L < 100 \text{ Ohm}$		400	1 100		nm
Integrale					
Empfindlichkeit	Stot 1)				
U _R = 10 V					
$E_V = 1 \text{ klx}^2$		500	200	0.00	44.76.14
SP 119		500	900		μA/kl×

µA/klx

500

300

	Kurzzeichen	min.	typ.	max.	Einheit
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit	λ_{s}				
Δλ _{0,5} = 10 nm	3				
R _L < 100 Ohm U _R = 20 V		-	900	-	nm
Impulsanstiegszeit und Impulsabfallzeit Lichtfleckdurch-	tr, tf				
messer	*				
- = 5 mm, = 2,1 mm					
(in der Mitte der aktiven Fläche)					
SP 119		-	5	-	μs
SP 121		2	60	-	μs
Laterale Inhomogenität der Fotostromempfind- lichkeit	S(L) S(0) . 100	-	5	-	x
U _R = 20 V A = 950 nm					
Normlichtart A mit B _g 19-Filter					
Pos. Linearitätsab- weichung え= 950 nm	Lp	2	2		x
Normlichtart A mit					
B _g 19-Filter					
Lateralwiderstand	P				
SP 119	RB		30		kÜhm
		7	200000	-	
SP 121		7	200		kOhm

¹⁾ beide Anoden verbunden, bei SP 119 auch beide Katoden verbunden.

²⁾ gemessen mit Normlichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geometrischen Achse.

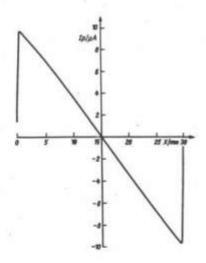
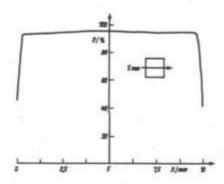


Bild 3: Positionslinearität SP 121



a)

Bild 4: Homogenität der Empfindlichkeit a) SP 119

b) SP 121

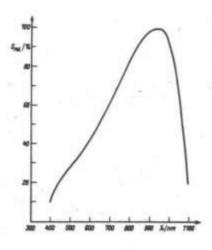
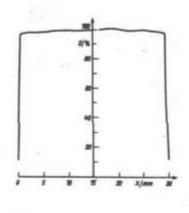
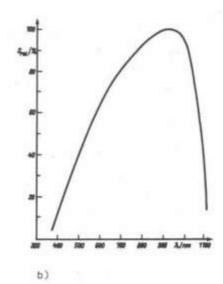


Bild 5: Relative spektrale Empfindlichkeit a) SP 119 b) SP 121

Änderungen vorbehalten! Redsktionsechluß 12/87



b)



Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber

veb applikationszentrum elektronik berlin im vab kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25

Berlin, 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055